

認証年度: 令和3(2021)年度

電子部品・デバイス・電子回路



株式会社パウデック



〒323-0028  
栃木県小山市若木町1-23-15  
<http://www.powdec.co.jp>  
JR小山駅から徒歩30分

お問い合わせ先  
TEL:0285-22-9986 FAX:0285-22-9987  
Email:info@powdec.co.jp



## ここがセールスポイント パワー半導体に自信あり！

当社は独自のMOCVD結晶成長技術を保有し、GaN系電子デバイス、光デバイスの開発・生産のインフラがあります。電子デバイスでは、高耐圧・高電流容量・高速動作を可能にするパワートランジスタ技術(PSJ)を持っています。

### 会社概要

代表者名 成井 啓修  
資本金 5,000万円  
年商 3億円  
従業員数 15名(パート含む)  
設立 平成13年5月  
取得規格

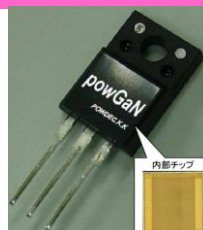
### 主な拠点・主要取引先

拠点: 本社小山事業所(小山市)  
取引先: 電機メーカー各社、大学、  
公的研究機関

### 事業内容

窒化ガリウム系パワー半導体素子  
および基板の開発・生産

わが社の《窒化ガリウムPSJ(分極超接合型)パワートランジスタ/ダイオード》にはこんな特徴があります！



当社開発PSJTランジスタ

当社のパワートランジスタ技術(PSJ)はAlGaNをGaNで挟み込む分極接合の新構造を採用することで従来のパワートランジスタでは実現できなかった高耐圧・高電流容量・高速動作を可能としました。10kVの高耐圧動作を達成し、更により実用性の高いノーマリーオフ型のパワーデバイスも実現しました。従来のパワーデバイスよりも高効率、小型化が可能で、モーター駆動用インバータ、電気自動車の急速充電装置、サーバー電源の他、放射線耐量が高く宇宙環境でも利用が期待されます。



代表取締役社長  
成井 啓修

### 社長からのメッセージ

当社は企業理念として“GaN系半導体素子インフラストラクチャーおよび基板の開発・生産を通じて、21世紀社会の構築に貢献する”を掲げ活動を行ってきました。今後も“環境にも人にも優しい再生可能エネルギーの未来を支えるためのキーデバイスやキーテクノロジーを開発するリーディングカンパニーとなる”をビジョンとし、邁進してまいります。

## その他にもこんなものを造っています！ 独自の技術力で各種デバイス構造を開発・製造

パウデックは独自設計のフェースダウンの多数枚チャージMOCVD装置を保有し、2インチ~5インチまでの結晶成長を行うことができます。お客様との密接な連携のもとに、GaN、AlGaN、InGaN、AlInGaNを含む各種デバイス構造の開発及び製造を承ります。

パウデックは、結晶成長からデバイスの開発および製造まで、お客様のご要望にあわせたスタイルでサポートさせていただきます。

